

DUODIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as H.F. and I.F. amplifier

DUODIODE-PENTHODE à pente variable pour l'utilisation comme amplificatrice H.F. et M.F.

DUODIODE-PENTHODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als H.F.- und Z.F. Verstärker

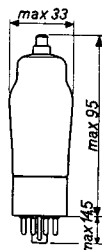
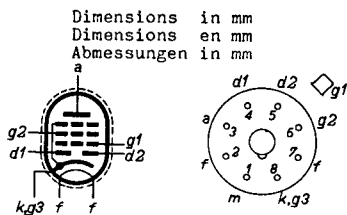
Heating: indirect by A.C. or D.C.; series or parallel supply.

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation en parallèle ou en série

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- oder Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,2 \text{ A}$



Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Pentode section
Partie penthode
Penthodenteil

$C_{g1} = 3,9 \text{ pF}$

$C_a = 8,5 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,01 \text{ pF}$

Diode section
Partie diode
Diodenteil

$C_{d1k} = 2,9 \text{ pF}$

$C_{d2k} = 2,9 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,45 \text{ pF}$

Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Penthodenteil

$C_{d1g1} < 0,001 \text{ pF}$ $C_{d1a} < 0,5 \text{ pF}$

$C_{d2g1} < 0,001 \text{ pF}$ $C_{d2a} < 0,25 \text{ pF}$

Operating characteristics of the pentode section as H.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F.- oder Z.F. Verstärker

Va=Vb =	250	200	100	V
Rg2 =	95	60	0	kΩ
Rk =	300	300	300	Ω
Vg1 =	-2 -38	-2 -32	-2 -16,5	V
Vg2 =	100 250	100 200	100 100	V
Ia =	5,0 -	5,0 -	5,0 -	mA
Ig2 =	1,6 -	1,6 -	1,6 -	mA
S =	1800 18	1800 18	1800 18	μA/V
Ri =	1,3 >10	1,0 >10	0,4 >10	MΩ

Limiting values of the pentode section

Caractéristiques limites de la partie penthode

Grenzdaten des Penthodenteiles

Va _o	= max. 550 V	Vg2 _o	= max. 550 V
Va	= max. 300 V	Wg2	= max. 0,3 W
Wa	= max. 1,5 W	Ik	= max. 10 mA
Vg2 (Ia < 2 mA)	= max. 300 V	Rg1	= max. 3 MΩ
Vg2 (Ia = 5 mA)	= max. 125 V	Rfk	= max. 20 kΩ
Vg1 (Igl=+0,3μA)	= max. -1,3 V	Vfk	= max. 100 V

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles

Vd1	= max. 200 V ¹⁾
Vd2	= max. 200 V ¹⁾
Id1	= max. 0,8 mA
Id2	= max. 0,8 mA
Vd1 (Id1 = +0,3 μA)	= max. -1,3 V
Vd2 (Id2 = +0,3 μA)	= max. -1,3 V
Rfk	= max. 20 kΩ
Vfk	= max. 100 V

1) Peak value; valeur de crête; Scheitelwert

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EBF32 sheet	date
1	1	1948.11.08
2	2	1948.11.08
3	FP	1999.06.15